

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

357/59

(54) DISPLAY DEVICE

(11) Kokai No. 53-144297 (43) 12.15.1978 (19) JP

(21) Appl. No. 52-59256 (22) 5.20.1977

(71) MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.

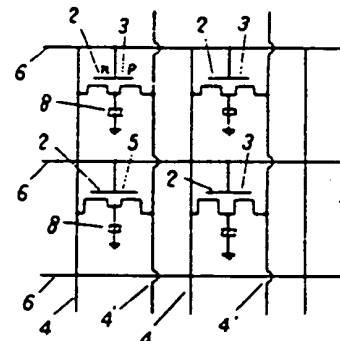
(72) KOU'SHIROU MORI(1)

(52) JPC: 101E5;101E9;101E9;104G0;97(7)B4

(51) Int. Cl.² G09F9 30; G02F1 13; G06K15.18; G09F9/00

PURPOSE: To obtain a matrix-type display device which features a long active life as well as the high reliability, by driving the display medium distributed corresponding to each of the picture element electrodes disposed in a matrix formation with the AC electric field featuring the perfectly symmetrical waveforms.

CONSTITUTION: The nematic liquid crystal featuring the positive inductive anisotropy is held between two sheet of Pyrex substrate 1 to be used as display medium 8. The picture element circuits in which complementary FET's composed of n-type thin film transistor FET2 and p-type FET3 are combined with picture element electrode 5 on the picture element surface are distributed vertically and horizontally in the matrix formation of many units onto the substrate surface of one side. The other side surface of the substrate is covered entirely with transparent electrodes to be earthed. In such constitution, gate electrode 6 and 6' plus lease electrode 4 and 4' are provided on the plane of the FET circuit group at the position where these to function as the drain electrode of the complementary FET. Thus, the AC driving becomes possible.



⑨日本国特許庁
公開特許公報

⑩特許出願公開
昭53—144297

⑪Int. Cl. ²	識別記号	⑫日本分類	庁内整理番号	⑬公開 昭和53年(1978)12月15日
G 09 F 9/30 //		101 E 5	7013—54	
G 09 F 1/13		101 E 9	7129—54	発明の数 1
G 06 K 15/18		101 E 9	6750—54	審査請求 未請求
G 09 F 9/00		104 G 0	7348—23	
		97(7) B 4	2116—56	(全 5 頁)

⑭表示装置

⑮特 願 昭52—59256

⑯出 願 昭52(1977)5月20日

⑰発明者 森幸四郎

門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

⑱発明者 深井正一

門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

⑲出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑳代理人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 書

1、発明の名称

表示装置

2、特許請求の範囲

2枚の基板間に表示媒体を介在させてなる表示装置であつて、一方の前記基板に、^(注電極と所記) 発光電極を設け、他方の前記基板に、制御電極とすると共に制御電極を共通接続して相対向に接続されるn型およびp型の薄膜トランジスタとが複数個形成され、他方の前記基板に、前記発光電極に対向した対向電極が形成されてなり、前記薄膜トランジスタの制御電極に交互に極性の異なる電界を印加することにより表示を行なうことを特徴とする表示装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は液晶やエレクトロミック材料を用いたマトリックス形の電気光学的な表示装置に関するものである。

マトリックス形の電気光学的な表示装置は、通常2枚の対向基板の間に電気光学的表示媒体を介在し、この表示媒体に電界を印加する手段を設け

て構成される。

ここで用いられる表示媒体は、液晶素子、エレクトロミネッセンス素子、エレクトロクロミック素子あるいは電気泳動形表示素子などの電気光学的素子を用いることができる。

一般にマトリックス表示装置を構成するには、表示媒体に選択的電界を印加するため、X軸方向に伸びる複数のストライプ状電極を設けた基板と、Y軸方向に伸びる複数のストライプ状電極を設けた基板との間に表示媒体を設け、両対向電極の交点に選択的電界を与えて、これらのマトリックス状に配列される結果を集合して画像表示する場合と、少なくとも一方の基板にマトリックス状に配列した発光電極を設け、これらに選択的電界を与え、結果の集合によって画像表示する場合とがある。

本発明は、特に後者のマトリックス形の電気光学的な表示装置に関するものである。

従来、この種の表示装置においては、表示媒体を選択的に動作するため、マトリックス状に配列

された各像素電極ごとに、CMOSトランジスタや電界効果型の薄膜トランジスタ（以下TFTと
言う）などが取付けられている。

ところで、CMOSトランジスタを各像素電極
に対応してマトリクス状に配列する場合、用い
る基板としては、シリコン基板を用いねばならず、
この結果表示装置は高価とならざるを得ず、また
シリコン単結晶基板の製作上、現在の半導体の技
術では、直径3〜4インチ程度の狭い表示面積の
基板しか入手しがたいなどの欠点を有している。

一方、TFTを各像素電極に対応してマトリッ
クス状に配列する場合、用いる基板には、ガラス
材を選ぶことができ、表示装置を安価に製作する
ことが可能であり、また現在の蒸着技術の許せる
範囲の広い表示面積を有する表示装置を構成でき
るなどの利点を有している。ところが、従来、T
FTをマトリクス駆動用素子に用いた表示装置
は、 n 型あるいは p 型半導体素子の1種であるた
め、表示媒体を駆動するのに、直流駆動に過して
いるが、交流駆動する場合は、TFTの特性の関

係上、表示媒体に波形が対称的な交流電界を与え
ることが明確な欠点がある。

ところで電気光学的表示装置では、表示媒体を
直流駆動あるいは波形が非対称な交流駆動をする
と、電極の腐食あるいは酸化腐食などの劣化ある
いは表示媒体の分解劣化を促進し、表示装置の動
作寿命を縮める原因となるので好ましくない。

本発明は、従来の係る欠点を克服した改良され
たマトリクス形の電気光学的な表示装置を提供
するものである。

すなわち、本発明の目的は、マトリクス状に
配設された各像素電極に対応して置かれる表示媒
体を、波形が完全に対称的な交流電界で駆動し、
動作寿命に富んだ信頼性の高いマトリクス形の
電気光学的な表示装置を提供することにある。

本発明のマトリクス形の電気光学的な表示装
置は、少なくとも一方の基板は透明であり、また
少なくとも一方の基板上に単位像素電極の複設か
らなる像素電極群および前記像素電極ごとに接続
された n 型TFTと p 型TFTとから成る相補型

TFT回路素子群がマトリクス状に配列され、
対向電極との間に置かれた電気光学的表示媒体を、
前記 n 型TFTと p 型TFTとに交互に順性の異なる
電界を印加することにより、対称的な波形をも
つ交流駆動をおこなしたものである。

本発明の表示装置において、一方の基板上にマ
トリクス状に配設される像素電極群と相補型T
FT回路素子群は、平面上で互いに重ならない位
置に、相補型TFTを駆動するためのソース電極
およびゲート電極が配設される。像素電極は相補
型TFTのドレイン電極としての役割をもち、対
向電極との間に置かれた表示媒体に電界を印加す
る。ソース電極は n 型TFTと p 型TFTとにそれ
ぞれ別々に接続され、ゲート電極は n 型TFTと p
型TFTとに共通に接続される。同様に、ドレイン
電極である像素電極も n 型TFTと p 型TFTとに
共通に接続される。

ソース電極とゲート電極が重なりをもつ箇所は
絶縁膜を設けてたがいに電気的に絶縁化される。
上述の回路構成において、ゲート電極側にブラ

スの電界を印加すると n 型TFTが作動し、この
場合 p 型TFTは遮断状態となり、一方ゲート電
極側にマイナスの電界を印加すると、 p 型TFT
が作動し、この場合 n 型TFTは遮断状態となる。

対向電極をアース状態にしておくと、 n 型T
FTが作動状態のとき、プラス電界がソース電極か
らドレイン電極に与えられ、対向電極に対してド
レイン電極がプラスの電位となって、表示媒体に
電界が印加され、一方、 p 型TFTが作動状態の
とき、マイナス電界がソース電極からドレイン電
極に与えられ、対向電極に対してドレイン電極が
マイナスの電位となって表示媒体に電界が印加さ
れることにより、表示媒体は、完全に波形が対称
的な交流で駆動されることになる。

以下実施例により本発明を図面を用いて更に詳
述する。

〔実施例1〕

一実施例として、電気光学的な表示装置として、
本発明を従来周知のツイスト型液晶表示装置に
適用して構成した。

6はゲート電極、7は電気絶縁性薄膜、8は表示媒体である。

次に、絶縁電極を配設した基板の具体的な製造法についてのべる。

まず、鏡面研磨されたバイレックスガラス基板を常法に従い表面洗浄する。次に上記基板1表面にアルミニウムを全面蒸着し、ホットエッチング法でライン状のソース電極4、4'とドレイン電極(絶縁電極に相当する)6とを形成する。

次いで、マスク合せしてCdSからなるn型半導体およびTeからなるp型半導体を順次蒸着し、n型TFT2およびp型TFT3を形成する。次に、ソース電極、n型TFT、p型TFTを被覆するように酸化シリコン絶縁膜7を蒸着し、次いで、ゲート電極8としてライン状にアルミニウム膜を設ける。ソース電極、ドレイン電極、ゲート電極としてはアルミニウムのほか、Au, Iaなどが用いられ、ドレイン電極としては、 InO_2 , SnO_2 などを主体とする金属酸化物を用いた透明電極を用いることもできる。

この液晶表示装置は、2枚のバイレックスガラス基板の間に正の誘電異方性を有するネマチック液晶を表示媒体としてはさんでいるが、一方の基板表面に、絶縁電極とn型TFTとp型TFTでなる相補型TFTとを組合せた絶縁回路を縦横に多数個マトリックス状に配列して設け、もう一方の基板表面は、全面的に透明電極を被覆してアース接続した。

第1図は本発明の一実施例における等価回路図を示し、第2図は第1図における一部拡大図を示すもので、単位絶縁電極とこの駆動回路素子の平面構成図を示している。

第3図a~cはゲートの駆動波形と、これに対応するドレインの駆動波形の時系列変化と、ドレインの駆動波形に対応する絶縁の光学的透過特性の時系列変化とを示している。

第1図、第2図において、同じ参照記号は、同様の素子を表わしており、1は、ガラス基板、2、3はそれぞれn型TFTおよびp型TFT、4、4'はソース電極、5は絶縁電極兼ドレイン電極、

TFTを構成する半導体材料としては、n型としてCdSのほか、CdS, PbS, PbSe, CdTeなどを、p型としてTeのほか、 InP , GaAs などを用いることができる。絶縁薄膜としては SiO_2 , SiO_2 , Al_2O_3 などを用いることができる。

これらの薄膜は、場合に応じて、真空蒸着法、化学的被覆法、ホットエッチング法などを利用して任意に形成できる。

上述の表示装置において、各素子の駆動について第3図a~cを用いて説明する。ゲート8にプラスの電圧 V_1 なる電圧が印加されると、n型TFT2のソース電極4とドレイン電極5が導通して、ソース電圧 V_2 が、ドレイン電極5を介して表示媒体8に印加される。同様にして、ゲート8にマイナスの電圧 $-V_1$ が印加されるとp型TFT3のソース4'からソース電圧 V_2 が表示媒体8に印加される。従って表示媒体8の光透過特性は第3図cの特性12, 12'のように変化し、波形歪を何らすることなく常に安定した表示が行なえる。

このようにして、表示媒体8は、完全に対称的な波形をもつ交流駆動が行なわれる。

〔実施例2〕

第4図は本発明の他の実施例の等価回路図を示している。第5図は同実施例の局部拡大図であり、単位絶縁電極とこれを駆動するための回路素子の構成を示している。第6図a~cは、ゲートの駆動波形と、これに対応するドレインの駆動波形の時系列変化とドレインの駆動波形に対応する絶縁の光学的透過特性の時系列変化とを示している。

第4図、第5図、第6図a~cは、前記実施例に示す第1図、第2図、第3図a~cにそれぞれ対応させて示される。また、使用される参照記号で、第1図、第2図、第3図a~cに示される参照記号と同一のものは、同様の素子を表わしている。

この実施例で示すマトリックス形電気光学的表示装置は、実施例1に示した表示装置とはほぼ同様の構成を有しているものであり、同一動作に關しては説明を省略する。特に構成上相異する点は、

表示媒体8に並列にコンデンサ9を配備したことがある。

このコンデンサ9は、第6図に示すように、絶縁電極6の表面を被覆するように誘電体皮膜9を設ければよい。この誘電体皮膜9には酸化イットリウム膜を設けたが、このほかに、 SiO_2 , SiO_2 , Al_2O_3 などを用いることができる。

このコンデンサ9を配備することにより、表示装置にメモリー機能をもたせ、TFT2および3が非動作状態時においても表示媒体8に実質的に持続的に電圧が印加された状態を保持させるものである。

これにより、マトリクス表示における時分割駆動を容易にすることができる。

第6図a, bに示すように、相補型TFTのはたらきにより表示媒体8は完全に電気的に対称的な波形をもつ交流駆動を行なえとともに、第6図cに示すように、コンデンサ9のはたらきにより、絶縁にドレイン電圧を取り去っても、持続的に電圧が印加される状態が保持されて光透過時間

が長くなり、表示装置をメモリー状態に置き、マトリクス表示における時分割駆動を容易にすることができる。

以上説明したように本発明の表示装置は、p型及びn型TFTを相補型に接続して得たものであるため、装置を交流駆動しても駆動信号は非対称とはならず、従って表示装置の寿命を一段と向上させることができ、表示装置の実用性を一層高めることができる。

4. 図面の簡単な説明

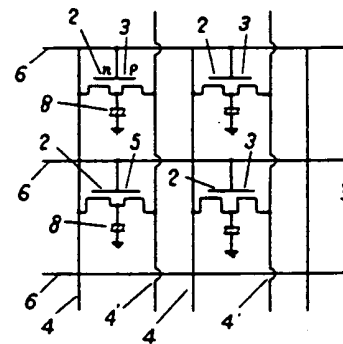
第1図は本発明の一実施例を示す等価回路図、第2図は同実施例の一部拡大平面図、第3図a～cは同実施例を駆動する際の信号波形図及び特性図、第4図は本発明の他の実施例を示す等価回路図、第5図は同実施例の一部拡大平面図、第6図a～cは同実施例を駆動する際の信号波形図及び特性図である。

1...ガラス基板、2...n型TFT、3...p型TFT、4, 4'...ソース電極、5...絶縁電極兼ドレイン電極、6...電極、

7...電気絶縁性薄膜、8...表示媒体、9...コンデンサ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図



So C 5 11

ツ

エミッタ

$e_m + - a$

153-144297(4)

にきき、マ
ずあにする

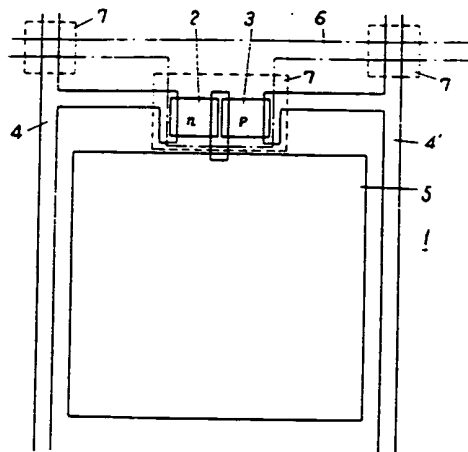
：層は、P型
！たものであ
！号は非対称
と一段と向上
！を一段高め

等価回路図、

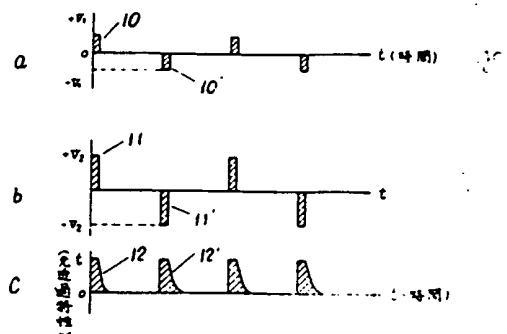
第3図。一
形図及び特性
示す等価回路
面図、第6図
号波形成及び

型IFT、3
ース電極、6
……電極、

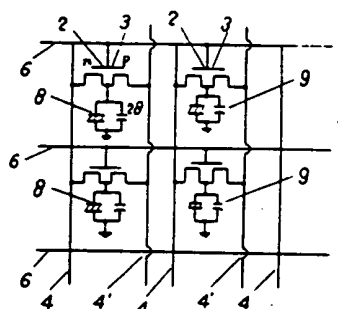
第 2 図



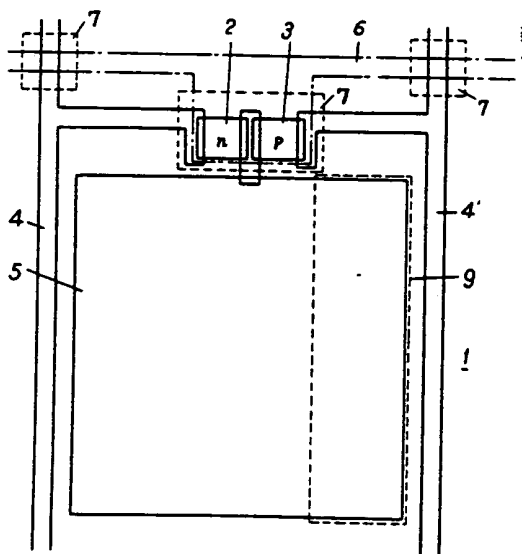
第 3 図



第 4 図



第 5 図



第 6 図

